(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2002-25402 (P2002-25402A)

(43)公開日 平成14年1月25日(2002.1.25)

(51) Int.Cl.7

識別記号

FΙ

テーマコード(参考)

H01H 37/76 C22C 28/00 H01H 37/76 C22C 28/00 F 5G502

В

審査請求 有 請求項の数2 OL (全 7 頁)

(21)出顧番号

特顧2000-200926(P2000-200926)

(22)出顧日

平成12年7月3日(2000.7.3)

(71)出顧人 591283040

ソルダーコート株式会社

愛知県名古屋市緑区鳴海町字長田75番地の

1

(72)発明者 成田 雄彦

愛知県名古屋市緑区鳴海町字長田75番地の

1 ソルダーコート株式会社内

(72)発明者 原 四郎

愛知県名古屋市緑区鳴海町字長田75番地の

1 ソルダーコート株式会社内

(74)代理人 100081776

弁理士 大川 宏

Fターム(参考) 50502 AA02 BB01

(54) 【発明の名称】 温度ヒューズおよび温度ヒューズ素子用線材

(57)【要約】

【課題】 本発明は、120℃以上130℃以下の溶断 温度を確保しうる温度ヒューズを提供することを課題と する。また、この温度ヒューズの製造に好適な温度ヒュ ーズ素子用線材を提供することを課題とする。

【解決手段】 本発明の温度ヒューズは、所定の温度で溶融するヒューズ素子を有する温度ヒューズであって、前記ヒューズ素子は、30重量%以上48重量%以下のスズと残部がインジウムとからなる可溶合金により形成されているととを特徴とする。また、本発明の温度ヒューズ素子用線材も同様の組成を有する可溶合金により形成されていることを特徴とする。つまり本発明は、可溶合金中のインジウム含有率を調整することで、優れた溶断温度特性、および適度な強度と延性を有する温度ヒューズおよび線材を提供するものである。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 所定の温度で溶断するヒューズ素子を有 する温度ヒューズであって、前記ヒューズ素子は、30 重量%以上48重量%以下のスズと、残部のインジウム とからなる可溶合金により形成されていることを特徴と する温度ヒューズ。

【請求項2】 30重量%以上48重量%以下のスズ と、残部のインジウムとからなる可溶合金により形成さ れている温度ヒューズ素子用線材。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は温度ヒューズおよび 温度ヒューズ素子用線材、より詳しくは所定の温度にて 溶融する無鉛可溶合金により形成した温度ヒューズ素子 を有する温度ヒューズおよび温度ヒューズ素子用線材に 関する。

[0002]

【従来の技術】ヒューズには、電気回路に過電流が流れ ると溶断して回路を保護する電気ヒューズと、電気回路 周辺の温度が上昇すると溶断して回路を保護する温度ヒ 20 ューズとがある。電気ヒューズはテレビ、洗濯機等に、 また温度ビューズは携帯電話、ノート型パソコン等に、 それぞれ組み込まれており、これらの電気製品を保護す る役割を有している。なかでも温度ヒューズは、設定し た溶断温度で、確実に、また迅速に溶断して電気回路を 守る必要がある。このため、温度ヒューズには様々な温 度条件に対し、精度よく溶断することが要求される。最 近の半導体等の電子部品は耐熱性の低いものが多く、1 20℃~130℃付近の温度で破損してしまうものが多 い。またリチウムイオン二次電池のように、温度が12 30 0℃~130℃付近まで上がると危険なものもある。と のため120℃~130℃付近の温度域で精度良く、迅 速に溶断する温度ヒューズが要求される。

【0003】ことで、ヒューズの溶断温度は、温度ヒュ ーズ中のヒューズ素子を構成する可溶合金の融点(液相 線温度)に左右され、融点は合金の成分金属およびその 配合比、つまり組成により決まる。従って、合金の組成 を選択するのは極めて重要である。

【0004】従来、融点が120℃~130℃である温 度ヒューズ用可溶合金としてはもっぱら原料金属の一種 40 に鉛を含むもの(以下鉛合金と称す)が使用されてい た。しかし、近年電気製品が廃棄されるとその中に組み 込まれている温度ヒューズから鉛が自然環境中に溶出す ることが問題となっている。環境中に溶出した鉛を人間 が摂取すると鉛中毒になり、摂取量により、疲労感、睡 眠不足、便秘、震え、腹痛、貧血、神経炎、脳変質症等 の中毒症状が現れる。したがって、鉛による環境汚染を 防止するため、可能な限り工業材料として鉛を使用しな いことが世界的に要求されており、鉛に代わる工業材料 の検討が、業界において重要な課題の一つとなってい

る。このため、特開平11-25829号公報には、鉛 合金を使用しない温度ヒューズとして、52~100重 量%のインジウムと、残部がスズとからなる合金により 形成される温度ヒューズが記載されている。

[0005]

【発明が解決しようとする課題】しかし、インジウムは 鉛、ビスマス等他の温度ヒューズ用金属と比較して高価 であり、インジウム含有率の高い合金からなる温度ヒュ ーズおよび線材は製造コストがかかるという問題があ 10 る。また、インジウムは柔らかいため、インジウム含有 率の高い合金からなる温度ヒューズおよび線材は傷が付 きやすく取り扱いに不便であるという問題がある。さら に、ヒューズの温度に対する溶断性を良くするため、筒 型ヒューズや管型ヒューズではヒューズ素子は一定の張 力をかけた状態で設置される場合が多いが、インジウム 含有率の高い線材からなるヒューズ素子は柔らかく延性 が高いため、張力をかけた状態で設置することが困難 で、温度ヒューズの溶断性が悪くなるという問題が生ず る。

【0006】そこで、温度ヒューズおよび線材を形成す るSn-In合金について鋭意研究を重ねた結果、本発 明の発明者は120℃以上130℃以下の温度において 溶融し、かつ低コストで温度ヒューズ素子を形成するの に適切な硬度および延性を有する無鉛可溶合金を得ると とができるとの知見を得た。

【0007】本発明の温度ヒューズおよび温度ヒューズ 素子用線材は、上記知見に基づいてなされたものであ り、120℃以上130℃以下の溶断温度を確保しうる 温度ヒューズを提供することを課題とする。また、この 温度ヒューズの製造に好適な温度ヒューズ素子用線材を 提供することを課題とする。

[00008]

【課題を解決するための手段】本発明の温度ヒューズ は、所定の温度で溶断するヒューズ素子を有する温度ヒ ューズであって、ヒューズ素子は、30重量%以上48 重量%以下のスズと、残部のインジウムとからなる可溶 合金により形成されていることを特徴とする。

【0009】また、本発明の温度ヒューズ素子用線材 は、30重量%以上48重量%以下のスズと、残部のイ ンジウムとからなる可溶合金により形成されていること を特徴とする。

【0010】前述したようにインジウムは、延性に富 み、硬度が低いという性質を有するため、Sn-In合 金中のインジウム含有率を調整することにより、120 ℃から130℃という比較的低温で溶融し、かつ適度な 延性と硬度を有する合金を得ることができる。ただし、 合金の△Tが大きいと、ヒューズの溶断に時間がかか り、電子部品が破損するおそれがあるため、可溶合金の △Tは30℃以内であることが要求される。

【0011】前述した組成を有する無鉛可溶合金からな

る本発明の温度ヒューズは、従来の鉛合金製温度ヒュー ズと同様に120℃以上130℃以下の溶断温度を確保 し、また△Tが30°C以内である実用的な温度ヒューズ となる。また、通常のインジウムを含む合金からなる温 度ヒューズ素子用線材と比較して、上記無鉛可溶合金か らなる本発明の温度ヒューズ素子用線材は、合金中のイ ンジウム含有率が低いため、柔らかすぎず適度な硬度を 有する。したがって、後述するように、線材製造時にお いて、線材をロール隙間に通して引っ張る際やボビンに 巻き取る際、線材が傷ついたりつぶれたりするおそれが 10 ない。このため、本発明の線材は従来の線材と比較し て、細線化することが可能で、耐熱性の低い電子部品や 小型電子機器等多彩な用途に使用することができる。 [0012]

【発明の実施の形態】以下、本発明の温度ヒューズおよ び温度ヒューズ素子用線材の実施の形態について、可溶 合金、温度ヒューズ、温度ヒューズ素子用線材の項目と とにそれぞれ説明する。

【0013】〈可溶合金〉まず、本発明の温度ヒューズ および温度ヒューズ素子用線材の形成材料である可溶合 20 金の態様について説明する。本発明の温度ヒューズおよ び線材に使用される可溶合金は、30重量%以上48重 量%以下のスズと、残部のインジウムとからなる。可溶 合金をこの様な組成とした理由を、図を参照しながら説

【0014】図1にSn-In二元系合金の状態図を示 す。図1中、点AはSn-In合金の共融点(48重量 %Sn-52重量%In)を示す。本発明の温度ヒュー ズおよび線材の目標とする溶断温度(以下目標温度と称 す)は120℃から130℃である。この目標温度でヒ ューズおよび線材を溶断させるためには、これらの形成 材料である可溶合金の液相線温度を120℃から130 ℃に設定する必要がある。液相線温度をこのような範囲 に設定できる組成は、図1中の点Aの左側の領域(Sn 含有率が48重量%以下の領域)と右側の領域(Sn含 有率が48重量%を越える領域)のそれぞれに存在す る。したがって、液相線温度のみから判断すれば、合金 の組成をどちらの領域に設定することも可能である。し かし、△Tは、点Aの左側の領域の方が、右側の領域と 比較して遥かに小さい。前述したように比較的低温にて 使用される温度ヒューズおいては、速断性を確保するた め、△Tが小さいことが要求される。このため点Aの左 側の領域、すなわちインジウム含有率が52重量%以上 の領域の方が合金組成を設定する領域として適当であ る。

【0015】△Tを小さくするという観点から見れば、 合金中のインジウム含有率は52重量%以上でありさえ すれば良いが、含有率を上げすぎると以下の問題が生ず る。すなわち、インジウムは、柔らかく延性に富み、硬 度が低いという性質を有する。このため合金中のインジ 50 1と、ヒューズ素子10、フラックス11およびリード

ウム含有率を上げすぎると、合金にもインジウムの性質 が現れ、合金自体が柔らかく、硬度が低いものとなる。 合金が柔らかいと、後述する線材製造時に、線材をロー ル隙間に通して引っ張る際やボビンに巻き取る際、線材 が傷ついたりつぶれたりするという問題が生ずる。ま た、インジウムは資源的埋蔵量が少なく、他のヒューズ 用合金と比較して、本来的に高価である。したがって、 インジウム含有率を上げすぎると、ヒューズおよび線材 の製造コストも必然的に高くなるという問題が生ずる。 このような問題が生ずるのを回避するため、合金が適度 な硬度を有し、かつヒューズおよび線材の製造コストを 抑制できる程度に、合金中のインジウム含有率を低くす る必要があり、具体的には70重量%以下とする必要が ある。

【0016】前述した合金の△T、および合金の硬度、 ヒューズ等の製造コストという観点から、本発明の発明 者は、本発明のヒューズおよび線材を形成する合金の組 成を、スズが30重量%以上48重量%以下、残部がイ ンジウムと決定した。

【0017】この組成範囲内において、スズとインジウ ムの配合比を変えるととにより、合金の融点を自在にコ ントロールすることができ、120°cから130°cの間 の任意の目標温度に対応する温度ヒューズおよび線材を 提供することができる。具体的には、目標温度が高い場 合は、スズ含有率を下げることにより合金の融点を上 げ、所望の目標温度に対応するヒューズおよび線材を提 供することができる。例えば、目標温度を130℃とす る場合は、可溶合金の組成を図1中の点B(30重量% Sn-70重量%Іп)に設定すればよい。一方、目標 温度が低い場合は、逆にスズ含有率を上げることにより 合金の融点を下げ、所望の目標温度に対応するヒューズ および線材を提供することができる。例えば、目標温度 を120℃とする場合は、可溶合金の組成を図1中の点 A (48重量%Sn-52重量%In) に設定すればよ

【0018】なお、可溶合金中には、原料金属等から不 可避の不純物が混入することも考えられる。本発明のヒ ューズおよび線材を構成する可溶合金は不純物の混入を 特に除外するものではなく、上記組成を有する合金に は、合金中に不可避の不純物が混入している場合も該当 する。

【0019】 〈温度ヒューズ〉 本発明の温度ヒューズの 実施の形態について、図を参照しながら説明する。図2 に本発明の温度ヒューズの一例として筒型温度ヒューズ の断面図を示す。図2に示す温度ヒューズ1は、一定の 温度で溶断するヒューズ素子10と、ヒューズ素子10 の両端に接合され電流を通すリード線2と、ヒューズ素 **子10の周囲に円柱状に充てんされヒューズ素子溶断後** に溶断面を被い再度導通が生じるのを防ぐフラックス1

線2の一部を収納する円筒状のセラミックケース12と からなる。

【0020】電子機器においては、温度ヒューズ1は例えば電池等の電源と電気回路等との間に設置される。何らかの原因で、温度ヒューズ1の周辺温度が上昇し、温度ヒューズ1の設定温度に達すると、ヒューズ素子10は溶断し、その溶断面をフラックス11が覆い、電源と回路等との導通を遮断する。このようにして温度ヒューズ1は電源、電気回路等を保護することができる。

【0021】本実施形態の温度ヒューズ1の製造方法に 10 ついては、従来からヒューズの製造に用いられている種々の方法により製造することができる。例えば、後述する線材を切断しヒューズ素子10を形成し、このヒューズ素子10とリード線2とを接合し、ヒューズ素子10の周囲にフラックス11を充てんし、さらにその外側に、ヒューズ素子10等を外部から保護するためセラミックケース12を設置する方法により製造することができる。

【0022】なお、本発明の温度ヒューズは、図2に示す筒型ヒューズの他、つめ付きヒューズ、管型ヒューズ、栓型ヒューズ等従来用いられている様々な形状の温度ヒューズとすることができる。

【0023】また、本発明の温度ヒューズは、120℃~130℃という比較的低温の任意の温度に対し、迅速 に溶断させることができる。このため、耐熱性の低い半 導体や携帯電話用リチウムイオン二次電池の保護用等、 多岐にわたる用途に使用することができる。

【0024】〈温度ヒューズ素子用線材〉次に、前述した温度ヒューズに用いられる本発明の温度ヒューズ素子用線材の実施の形態について説明する。本発明の線材は、従来線材の製造に用いられてきた種々の方法により製造するととができる。その一例として引抜き法について説明する。

【0025】引抜き法は、線材を構成する可溶合金の原料を溶融炉に配合する原料配合工程、配合した原料を溶融させ合金を調製し型に流し込みビレットを作るビレット作製工程、ビレットから粗線を作製する押出し工程、粗線から細線を成形する伸線工程からなる。

【0026】まず、原料配合工程では、線材の原料であるスズ、インジウムの地金を所望の組成となるように秤 40量、配合し溶融炉に投入する。次に、ピレット作製工程では、配合原料を300~350℃の温度下で溶融させSn-In合金を調製し、溶融状態の調製合金を型に流し込み、柱状のビレットを作製する。次に、押出し工程では、型からビレットを取り出し、押出し成形機にかけ、押し出し成形することで粗線を作製する。最後に、伸線工程では粗線を引抜き成形機にかけ、成形機に設けられた円形のダイス孔から線状の合金を引き抜くことにより細線、すなわち線材を成形する。ダイス孔は順次径が小さくなっており、多数のダイス孔を通る間に所定の 50

径が得られるようになっている。合金をダイス孔から引き抜き線材を得るためには、ダイス孔の出側にて線材に張力を与えることが必要である。このためダイス孔出側にて、線材を一対のロールの隙間に通している。このロールにより張力をかけられ、合金はダイス孔から引き抜かれることになる。その後ロールを出た線材はボビン等に巻き取られ保管される。

【0027】上記引抜き法の様に、張力により線材を成形する方法においては、線材中のインジウム含有率が高いと、線材が柔らかくなり過ぎるため、引抜き成形において線材をロール隙間に通す際や線材をボビンに巻き取る際に、線材が傷付いたり、つぶれてしまうおそれがある。したがって、このような方法では成形することができない。一方、本実施形態の温度ヒューズ素子用線材は、インジウム含有率が低く適度な硬度を有するため、線材をロール隙間に通したりボビンに巻き取っても傷が付いたりつぶれたりすることが無く、このような方法で成形することが可能である。なお、線材は、軸方向に対する垂直方向の断面が真円状のものの他、楕円状、多角形状等従来用いられている様々な断面形状の線材とすることができる。

【0028】また、比較的低い温度にて溶断する温度ヒューズにおいては、耐熱性の低い半導体等の電子部品を保護するため設定温度に対する速断性が要求される。前述したように線材からなるヒューズ素子は、速断性を確保するため、ヒューズ内において一定の張力がかけられた状態で設置される場合が多い。この状態で設置されたヒューズ素子は、断面積が小さいほどより迅速に溶断するので、このようなヒューズ素子に用いる線材にも断面積が小さいことが要求される。

【0029】さらにまた、本発明の線材は溶断温度が120°C以上130°C以下だが、との温度域で溶断する線材を有するヒューズは、ノート型パソコン等の小型電子機器の保護用として需要が高まっている。近年これらの電子機器は、利用の便から小型化の一途をたどっており、機器の小型化のためには、その部品である温度ヒューズも小型であることが要求され、温度ヒューズ素子用線材の断面積も小さいととが要求される。

【0030】上記ニーズより、線材の断面積は0.3mm²以下であることが要求される。この様な断面積の小さい線材にとっては、線材が傷付いたりつぶれたりすることは致命傷となる。すなわち、線材が傷付いたりつぶれたりすると、その部分だけ断面積が変わり、傷の有無やつぶれ具合により同じ設定温度のヒューズであっても溶断時間にばらつきが発生するからである。インジウム含有率の高いヒューズ用線材は、柔らかいので傷が付きやすくまたつぶれやすかった。このため、溶断時間にばらつきが発生しやすく信頼性の低いものが多かった。一方、本発明の線材は、インジウム含有率が低い上記可溶合金により形成されるため傷が付きにくくまたつぶれに

8

くい。このため、ばらつきの小さい信頼性の高い線材と することができる。

[0031]

【実施例】上記実施形態に基づいて、所定の組成を有する るIn-Sn合金製の試料を作製し実験を行った。これ を実施例として説明する。

【0032】〈実施例1〉実施例1の試料は、32重量%のスズ、68重量%のインジウムという組成を有する可溶合金により構成されている。この試料は以下の方法により製造した。まず、純度99.99%のスズ、純度 1099.99%のインジウムを秤量し、溶融炉に投入した。次に、原料を溶融炉にて300℃の温度下で溶融攪拌して合金の調製を行い、調製合金を型に流し込み放冷し、脱型した。このようにして作製したインゴットから試料を採取し、これを実施例1とした。また、調製合金を型に流し込む際、化学分析にて合金組成の確認を行った

【0033】〈実施例2〉実施例2の試料は、35重量 %のスズ、65重量%のインジウムという組成を有する 可溶合金により構成されている。この試料を採取したイ 20 ンゴットは上記実施例1のインゴットと同様の方法によ り製造した。

【0034】〈実験方法〉実験は、実施例1、2の試料を加熱炉にて徐々に加熱し、熱分析計(以下TAと称す)、示差走査熱量計(以下DSCと称す)を用いて各試料についての溶融温度特性を調べることにより行った。加熱炉の昇温バターンは、実験前の温度を50℃、*

*昇温速度を毎分10℃、最終保持温度を150℃とし た。

【0035】〈実験結果〉との昇温バターンにて実施例 1の試料を昇温したときの、TAによる測定結果を図3に示す。図3より、温度が約126℃と約128℃のとき温度曲線に変曲点があることが分かる。また、DSCによる測定結果を図4に示す。図4より、温度が約126℃のときに示差熱曲線にピーク開始点があることが分かる。これらのことから、実施例1の試料を構成する可溶合金は、約126℃で固相単独の一相状態から固相と被相との二相共存状態となり、約128℃で二相共存状態から液相単独の一相状態に相変化することが分かる。すなわち、実施例1においては約126℃が固相線温度、約128℃が液相線温度であり、△Tは約2℃であることが分かる。

【0036】同様に実施例2の試料を昇温したときの、 TAによる測定結果を図5に示す。図5より、温度が約 123℃と約126℃のとき温度曲線に変曲点があることが分かる。また、DSCによる測定結果を図6に示す。図6より、温度が約123℃のときに示差熱曲線にピーク開始点があることが分かる。すなわち、実施例2においては約123℃が固相線温度、約126℃が液相線温度であり、△Tは約3℃であることが分かる。

【0037】以上の実験から実施例1、2の試料の組成、融点、△Tをまとめて表1に示す。

[0038]

【表1】

	組成(重量%)		(℃) 点蝴		ΔT (°C)
	Sn	I n	固相線温度	液相線温度	1
実施例1	3 2	6 8	1 2 6	1 2 8	2
実施例2	3 5	6 5	1 2 3	1 2 6	3

【0039】表1より、実施例1、2は120 \mathbb{C} 以上130 \mathbb{C} 以内という温度範囲内に液相線温度があることが分かった。また、実施例1、2の Δ Tはいずれも30 \mathbb{C} よりも遥かに小さかった。

[0040]

【発明の効果】本発明の温度ヒューズは、所定の温度で溶断するヒューズ素子を有する温度ヒューズであって、前記ヒューズ素子は、30重量%以上48重量%以下のスズと、残部のインジウムとからなる可溶合金により形成されていることを特徴とする。

【0041】また本発明の温度ヒューズ素子用線材は、30重量%以上48重量%以下のスズと、残部のインジウムとからなる可溶合金により形成されていることを特徴とする。

【0042】 このように、可溶合金としてSn-In合 50

金を選択し、また合金中のインジウム含有率を低くする ことで、優れた溶断温度特性と適度な硬度および延性を 有する温度ヒューズおよび線材となる。

【図面の簡単な説明】

【図1】Sn-In合金の状態図である。

【図2】温度ヒューズの断面図である。

【図3】実施例1のTAによる分析結果を示すグラフである。

【図4】実施例1のDSCによる分析結果を示すグラフ である。

【図5】実施例2のTAによる分析結果を示すグラフで ぁス

【図6】実施例2のDSCによる分析結果を示すグラフ である。

【符号の説明】

10

A:Sn-In二元系合金の共融点

B: Sn30重量% In70重量%の点

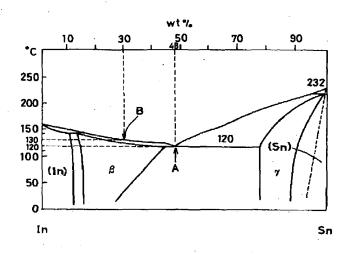
1:温度ヒューズ 10:ヒューズ素子 * 11:フラックス 12:セラミックケース

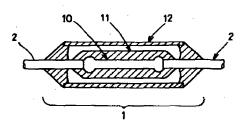
2:リード線

*

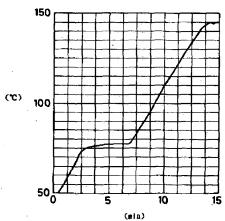
【図1】

[図2]

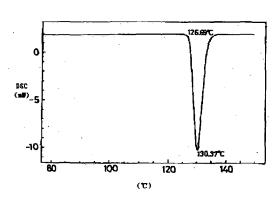




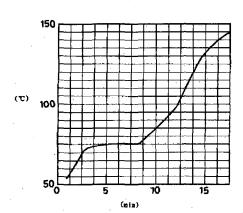
【図3】



【図4】



【図5】



【図6】

